

این دیتاشیت توسط توکل الکترونیک تهیه و ارائه شده است.
جهت مشاهده قیمت، موجودی و ثبت سفارش این قطعه به وبسایت توکل الکترونیک مراجعه فرمایید.



مشاهده قیمت و خرید
برای خرید و مشاهده سایر محصولات کلیک کنید



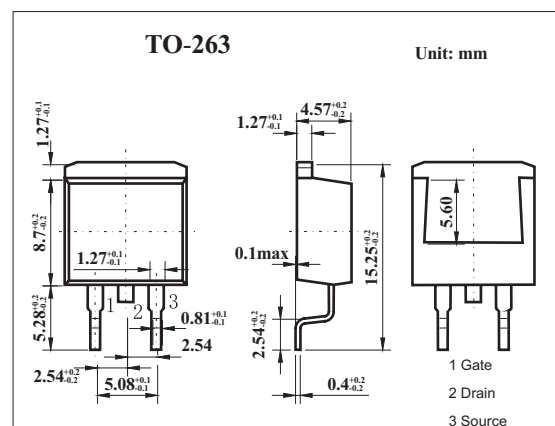
SMD Type

MOSFET

MOS Field Effect Transistor 2SK3296

■ Features

- 4.5 V drive available
- Low on-state resistance
 $R_{DS(on)1} = 12m\Omega$ MAX. ($V_{GS} = 10V$, $I_D = 18A$)
- Low gate charge
 $Q_G = 30nC$ TYP. ($I_D = 35A$, $V_{DD} = 16V$, $V_{GS} = 10V$)
- Built-in gate protection diode
- Surface mount device available



■ Absolute Maximum Ratings $T_a = 25^\circ C$

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Drain to source voltage	V_{DS}	20	V
Gate to source voltage	V_{GS}	± 20	V
Drain current	I_D	± 35	A
	I_{DP}^*	± 140	A
Power dissipation	P_D	1.5	W
		40	
Channel temperature	T_{ch}	150	$^\circ C$
Storage temperature	T_{stg}	-55 to +150	$^\circ C$

* $PW \leq 10\mu s$, Duty Cycle $\leq 1\%$

■ Electrical Characteristics $T_a = 25^\circ C$

Parameter	Symbol	Testconditions	Min	Typ	Max	Unit
Drain cut-off current	I_{DSS}	$V_{DS}=20V, V_{GS}=0$			10	μA
Gate leakage current	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS}=0$			± 10	μA
Gate cutoff voltage	$V_{GS(off)}$	$V_{DS}=10V, I_D=1mA$	1.0		2.5	V
Forward transfer admittance	$ Y_{fs} $	$V_{DS}=10V, I_D=18A$	9.0			S
Drain to source on-state resistance	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=18A$		8.5	12	$m\Omega$
		$V_{GS}=4.5V, I_D=18A$		12	19	$m\Omega$
Input capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=10V, V_{GS}=0, f=1MHz$		1300		pF
Output capacitance	C_{oss}			570		pF
Reverse transfer capacitance	C_{rss}			300		pF
Turn-on delay time	t_{on}	$I_D=18A, V_{GS(on)}=10V, R_G=10\Omega, V_{DD}=10V$		70		ns
Rise time	t_r			1220		ns
Turn-off delay time	t_{off}			100		ns
Fall time	t_f			180		ns